

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2741266

Полупроводниковый газоанализатор угарного газа

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (ОмГТУ) (RU)*

Авторы: *Кировская Ираида Алексеевна (RU),
Васина Марина Владимировна (RU)*

Заявка № 2020120160

Приоритет изобретения 18 июня 2020 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 22 января 2021 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 18 июня 2040 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Г.П. Ивашин".

Г.П. Ивашин





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(52) СПК
G01N 27/12 (2020.08)

(21)(22) Заявка: 2020120160, 18.06.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
18.06.2020

Дата регистрации:
22.01.2021

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 18.06.2020

(45) Опубликовано: 22.01.2021 Бюл. № 3

Адрес для переписки:

644050, г. Омск, пр-кт Мира, 11, ОмГТУ,
Информационно-патентный отдел, Бабенко
О.И.

(72) Автор(ы):

Кировская Ираида Алексеевна (RU),
Васина Марина Владимировна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный
технический университет"(ОмГТУ) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 196523 U1, 03.03.2020. US
20190257784 A1, 22.08.2019. US 20190360955 A1,
28.11.2019. Кировская И.А. "Создание новых
материалов для анализаторов экологического
назначения" Журнал "Современные проблемы
науки и образования", - 2006. - N 3. Кировская,
И. А. и др. "Химический состав и кислотно-
основные свойства поверхности твердых
растворов (ZnTe) (см. прод.)

(54) Полупроводниковый газоанализатор угарного газа

(57) Формула изобретения

Газовый датчик, содержащий полупроводниковое основание, нанесенное на непроводящую подложку, отличающийся тем, что полупроводниковое основание выполнено из поликристаллической пленки твердого раствора $(\text{CdSe})_{0,5}(\text{ZnTe})_{0,5}$.

(56) (продолжение):

х (CdSe) 1-х" Журнал "Омский научный вестник", 2014 г. (1 (127)), 32-37.

RU 2 741 266 C1

RU 2 741 266 C1